



Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБЧ153-1000-14

Средний прямой ток	I_{TAV}	1000 А		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	1000 ÷ 1400 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}			
Время выключения	t_q	10.0; 12.5; 16.0; 20.0 μ s		
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	1000	1200	1400	
Класс по напряжению	10	12	14	
$T_j, ^\circ C$	- 60 ÷ 125			

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	1000 1330	$T_c=78^\circ C$; двухстороннее охлаждение; $T_c=55^\circ C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	1570	$T_c=78^\circ C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	19.0 21.8	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=500$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			20.0 23.0	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=500$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	1805 2375	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=500$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс
			1660 2195	$T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=500$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000÷1400	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100÷1500	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max};$ управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	8	$T_j = T_{j\ max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	8	$T_j = T_{j\ max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	2500	$T_j = T_{j\ max}; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ $I_{TM} = 2 I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G = I_{FGM}; U_G = 20$ В; $t_{GP} = 500$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°С	- 60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°С	- 60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	24.0÷28.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.30	$T_j = 25$ °С; $I_{TM} = 3140$ А
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.350	$T_j = T_{j\ max};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.35	
I_L	Ток включения, макс	мА	20000	$T_j = 25$ °С; $U_D = 12$ В; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}; U_G = 20$ В; $t_{GP} = 500$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
I_H	Ток удержания, макс	мА	500	$T_j = 25$ °С; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики				
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	150	$T_j = T_{j\ max};$ $U_D = U_{DRM}; U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	1000	$T_j = T_{j\ max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто

Характеристики управления					
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.25	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	10.00		

Динамические характеристики

t_{gd}	Время задержки включения	мкс	2.00	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; V_D = 0.4 \cdot V_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV};$ Gate pulse: $I_G = I_{FGM}; V_G = 20 \text{ В};$ $t_{GP} = 500 \text{ } \mu\text{s}; di_G/dt = 1 \text{ А}/\mu\text{s}$	
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	10.0; 12.5; 16.0; 20.0	$dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс};$	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 \text{ А}/\text{мкс};$ $U_R = 100 \text{ В};$ $U_D = 0.67 U_{DRM};$
			12.5; 16.0; 20.0; 25.0	$dv_D/dt = 200 \text{ В}/\text{мкс};$	
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	150	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -50 \text{ А}/\text{мкс};$ $U_R = 100 \text{ В};$	
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	4.0		
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	А	100		

Тепловые характеристики

R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0.0210	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0462		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0378		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0.0040	Постоянный ток	

Механические характеристики

w	Масса, тип	г	550	
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	29.47 (1.160)	
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	17.50 (0.689)	

ПРИМЕЧАНИЕ

¹⁾ Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии

Обозначение группы	A2
$(dv_D/dt)_{crit}$, В/мкс	1000

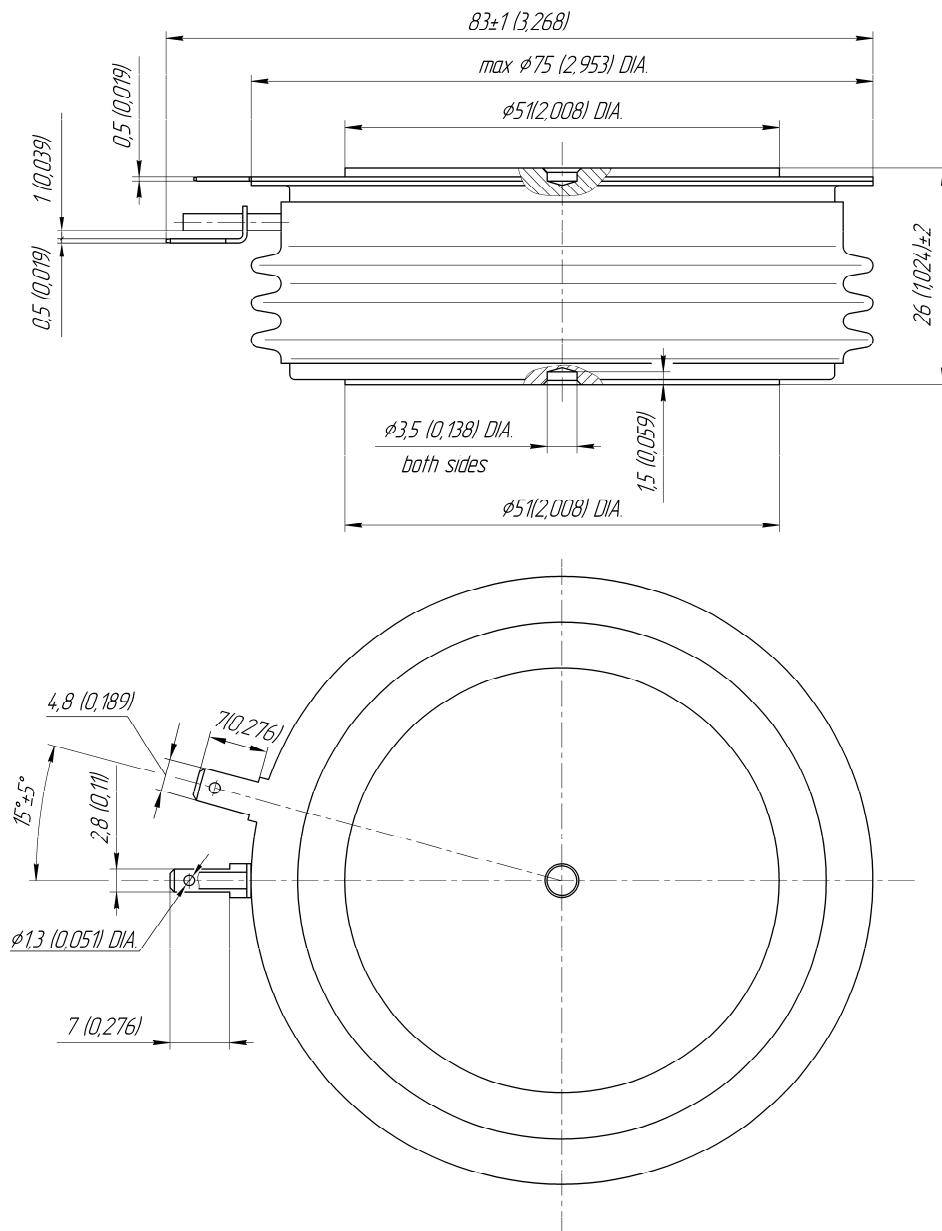
²⁾ Время выключения ($dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$)

Обозначение группы	A4	X3	T3	P3
t_q , мкс	10.0	12.5	16.0	20.0

МАРКИРОВКА

ТБЧ	153	1000	14	A2	A4	УХЛ2
1	2	3	4	5	6	7

1. Быстродействующий импульсный тиристор
2. Конструктивное исполнение
3. Средний ток в открытом состоянии, А
4. Класс по напряжению
5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
6. Группа по времени выключения ($dv_D/dt = 50 \text{ В}/\text{мкс}$)
7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

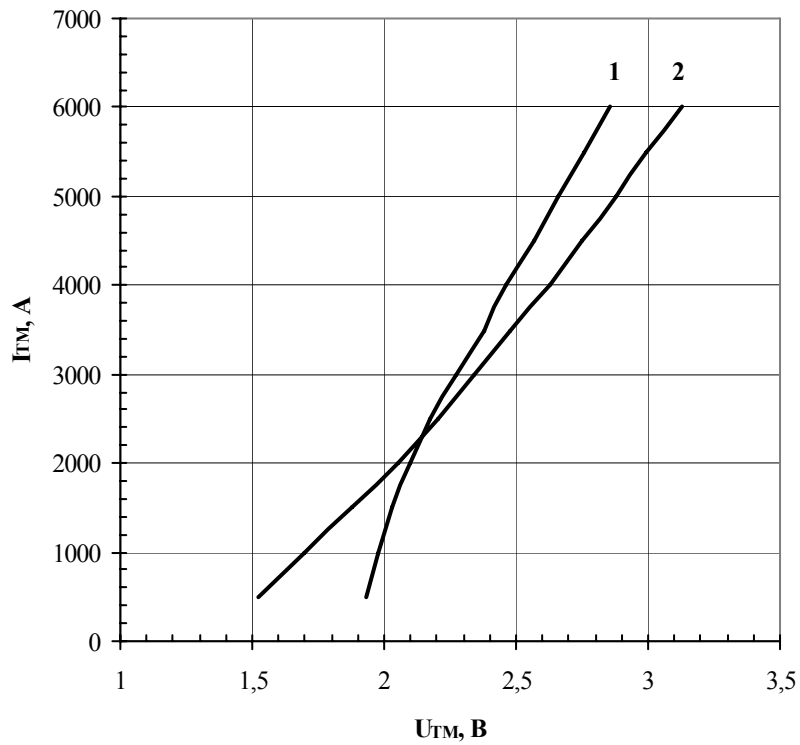
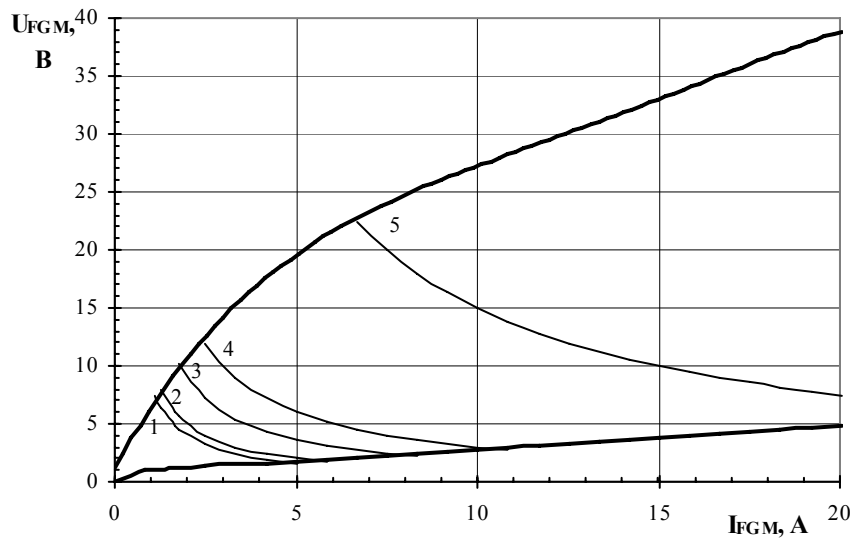


Fig. 1 On-state characteristics of Limit device
 1 – $T_j=25\text{ °C}$
 2 – $T_j=125\text{ °C}$



Maximum peak gate power loss

Position	On-Off time ratio	Gate pulse length, ms	Gate Pulse Power, W
1	1	DC	8
2	2	10	10
3	20	1	18
4	40	0.5	30
5	200	0.1	150

Fig. 2 Gate characteristics

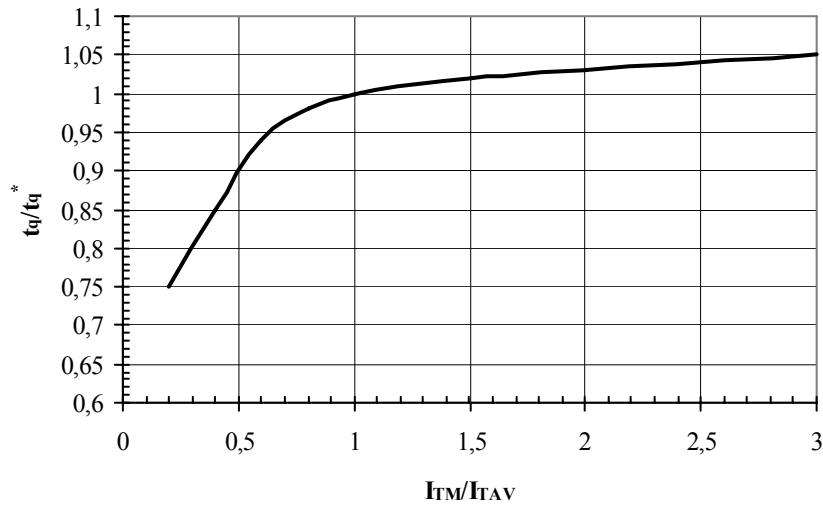


Fig. 3 Turn-off time t_q vs. On-state peak current I_{TM}

Conditions: $T_j=T_{j\ max}$; $di_R/dt=10\ A/\mu s$; $V_R=100\ V$; $dv_D/dt=50\ V/\mu s$; $V_D=0.67\cdot V_{DRM}$

Typical changes of t_q are normalized to the t_q^* (t_q^* – see data sheet, $dv_D/dt=50\ V/\mu s$)

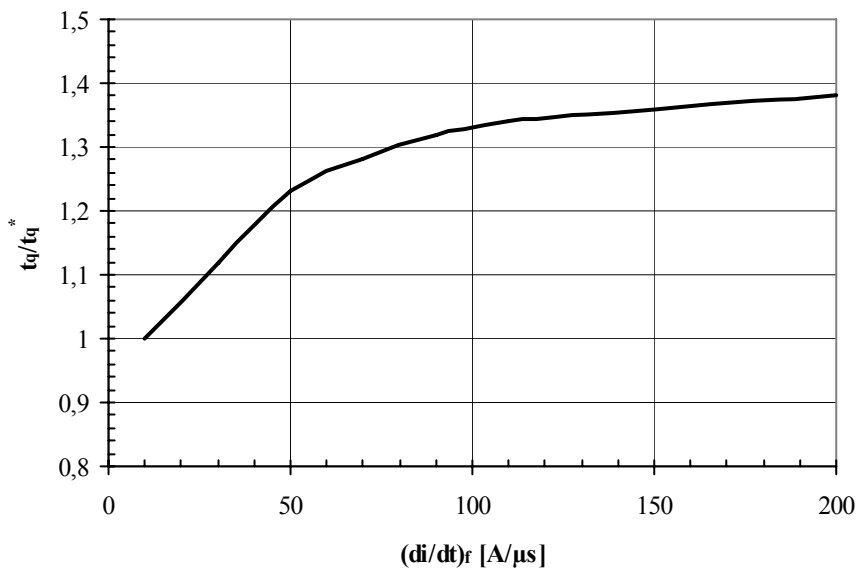


Fig. 4 Turn-off time t_q vs. Rate of fall of on-state current di_R/dt

Conditions: $T_j=T_{j\ max}$; $I_{TM}=I_{TAV}$; $V_R=100\ V$; $dv_D/dt=50\ V/\mu s$; $V_D=0.67\cdot V_{DRM}$

Typical changes of t_q are normalized to the t_q^* (t_q^* – see data sheet, $dv_D/dt=50\ V/\mu s$)

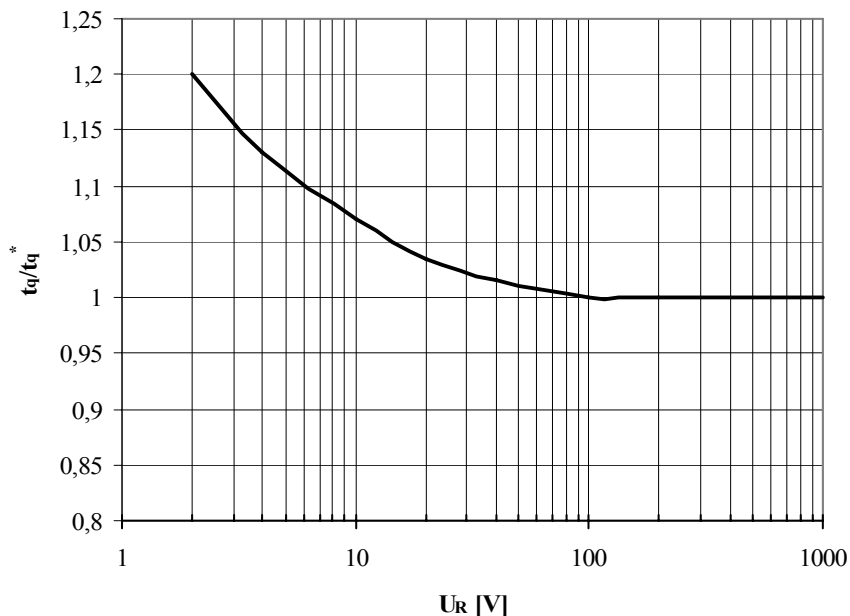


Fig. 5 Turn-off time t_q vs. Reverse voltage V_R

Conditions: $T_j = T_{j \max}$; $I_{TM} = I_{TAV}$; $di_R/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$; $dv_D/dt = 50 \text{ V}/\mu\text{s}$; $V_D = 0.67 \cdot V_{DRM}$
 Typical changes of t_q are normalized to the t_q^* (t_q^* – see data sheet, $dv_D/dt = 50 \text{ V}/\mu\text{s}$)

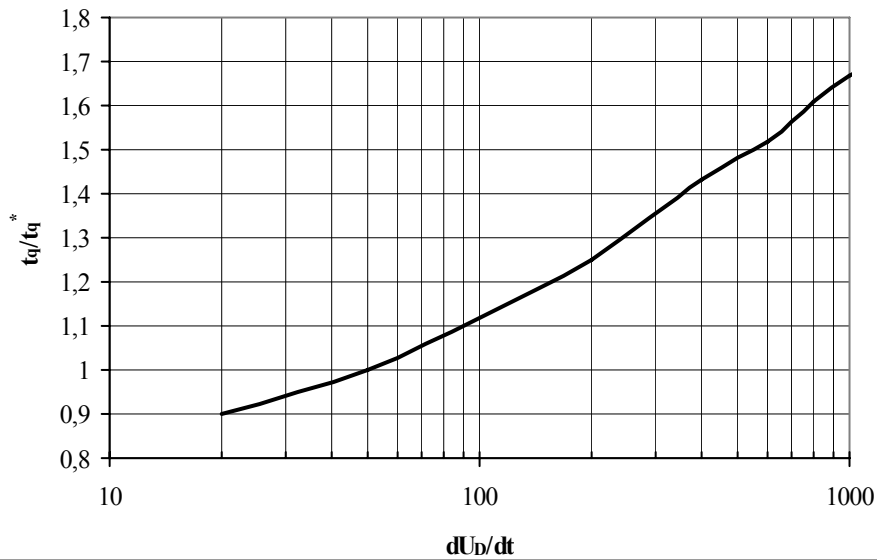


Fig. 6 Turn-off time t_q vs. Rate of rise of commutating voltage dv_D/dt

Conditions: $T_j = T_{j \max}$; $I_{TM} = I_{TAV}$; $di_R/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 100 \text{ V}$; $V_D = 0.67 \cdot V_{DRM}$
 Typical changes of t_q are normalized to the t_q^* (t_q^* – see data sheet, $dv_D/dt = 50 \text{ V}/\mu\text{s}$)

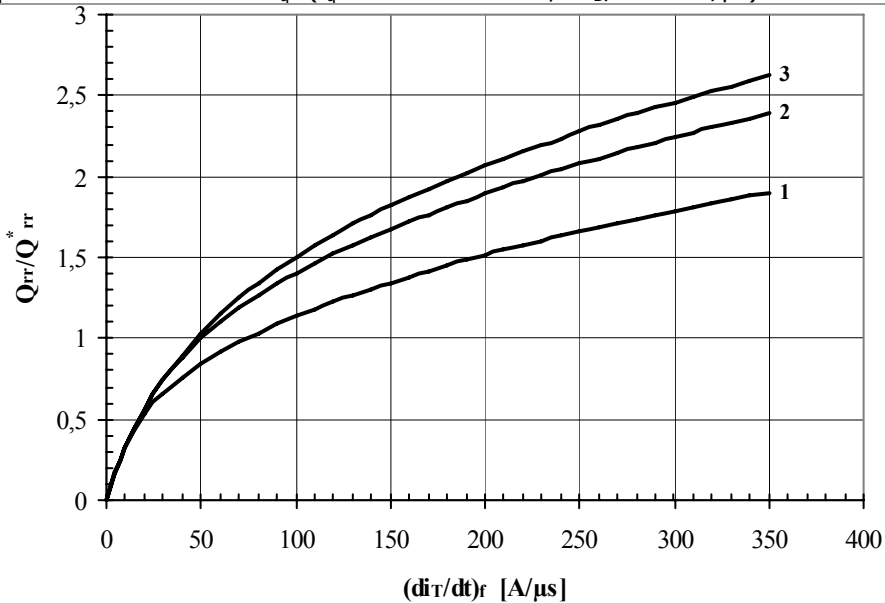


Fig. 7 Reverse recovery charge Q_{rr} vs. Rate of fall of on-state current di_R/dt

- 1 – $I_{TM} = 0.5 \cdot I_{TAV}$
- 2 – $I_{TM} = I_{TAV}$
- 3 – $I_{TM} = 1.5 \cdot I_{TAV}$

Conditions: $T_j = T_{j \max}$; $V_R = 100 \text{ V}$
 Typical changes of Q_{rr} are normalized to the Q_{rr}^* (Q_{rr}^* – see data sheet)

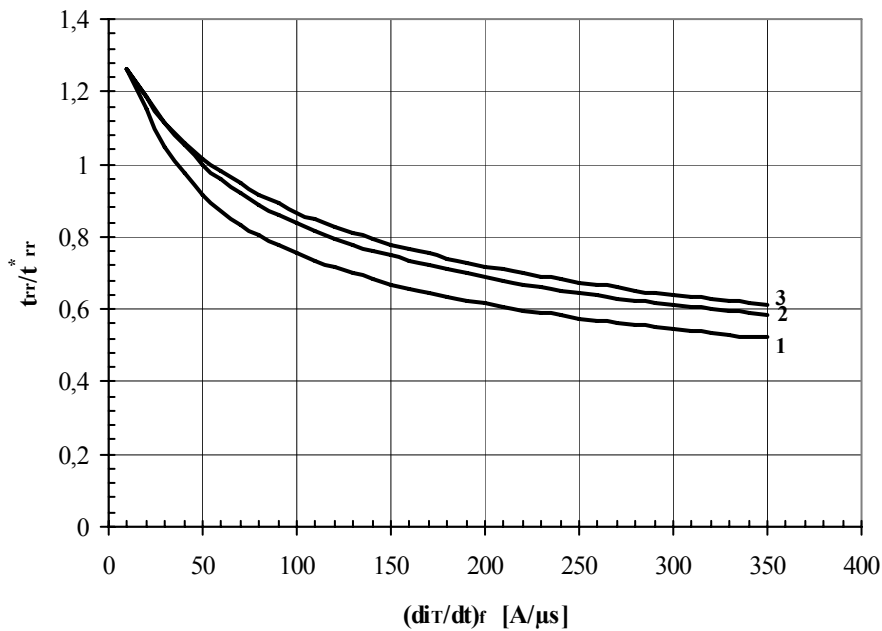


Fig. 8 Reverse recovery time t_{rr} vs. Rate of fall of on-state current di_R/dt

1 - $I_{TM} = 0.5 \cdot I_{TAV}$

2 - $I_{TM} = I_{TAV}$,

3 - $I_{TM} = 1.5 \cdot I_{TAV}$

Conditions: $T_j = T_{j \max}$; $V_R = 100$ V

Typical changes of t_{rr} are normalized to the t_{rr}^* (t_{rr}^* – see data sheet)

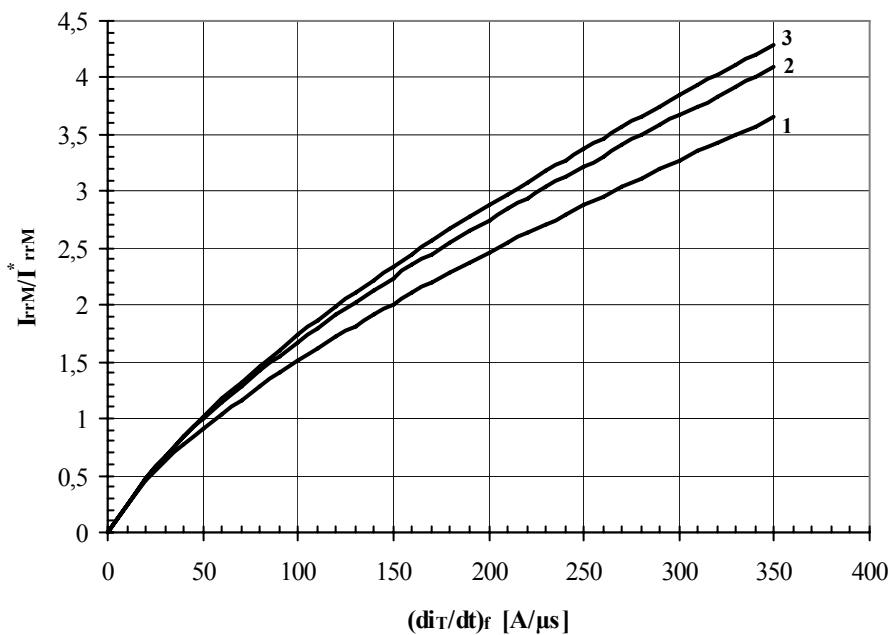


Fig. 9 Peak reverse recovery current I_{rrM} vs. Rate of fall of on-state current di_R/dt

1 - $I_{TM} = 0.5 \cdot I_{TAV}$

2 - $I_{TM} = I_{TAV}$,

3 - $I_{TM} = 1.5 \cdot I_{TAV}$

Conditions: $T_j = T_{j \max}$; $V_R = 100$ V

Typical changes of I_{rrM} are normalized to the I_{rrM}^* (I_{rrM}^* – see data sheet)

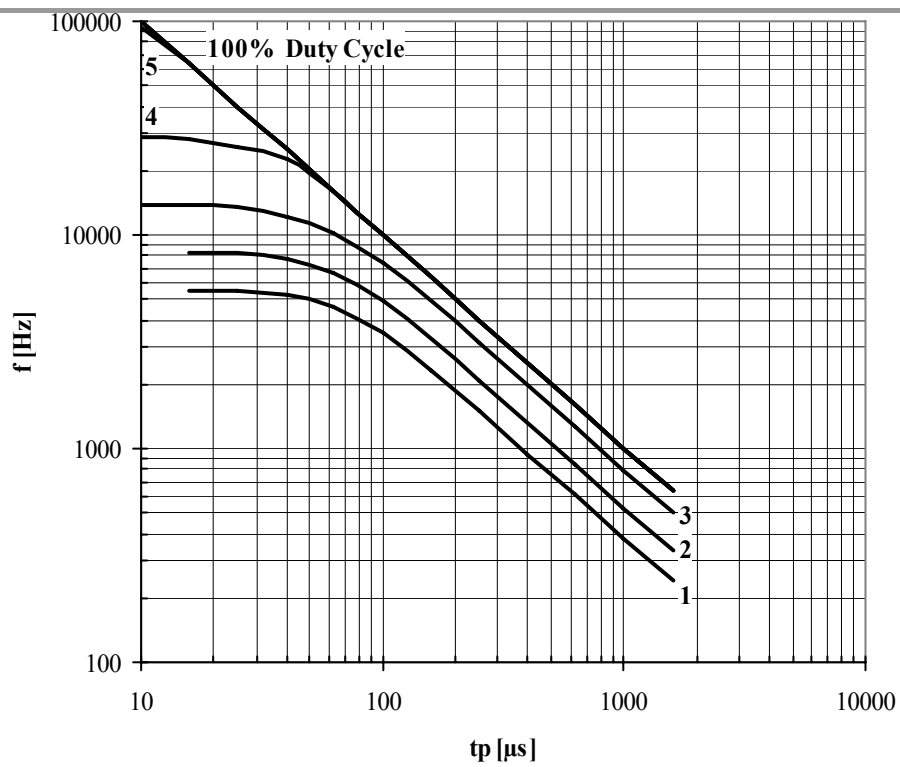


Fig. 10 Sine wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V; $T_C = 55$ °C

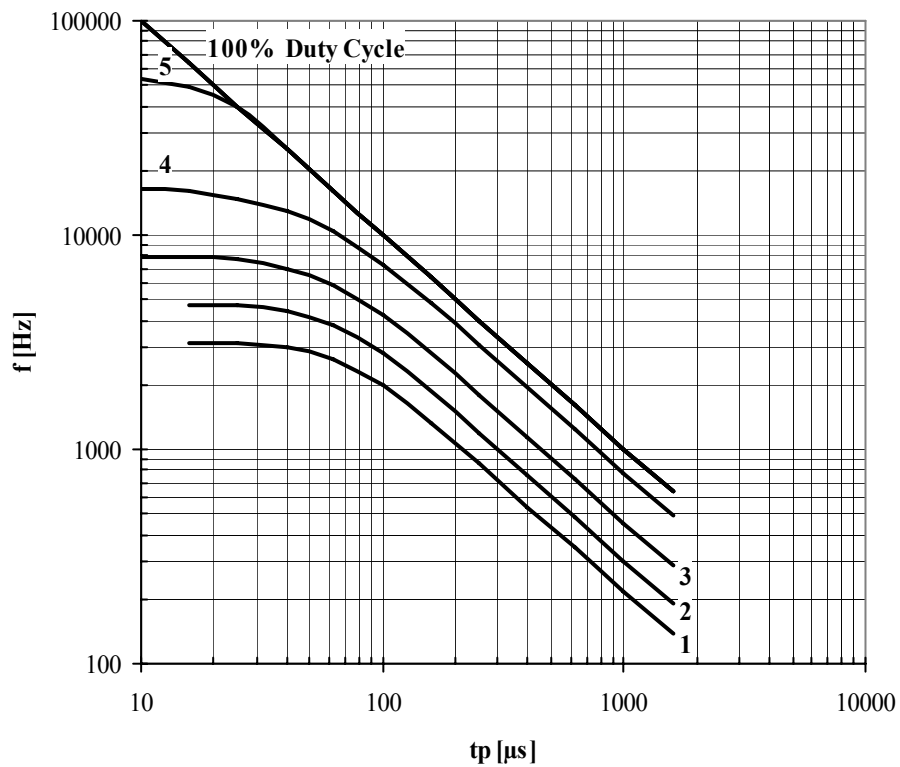


Fig. 11 Sine wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V; $T_C = 78$ °C

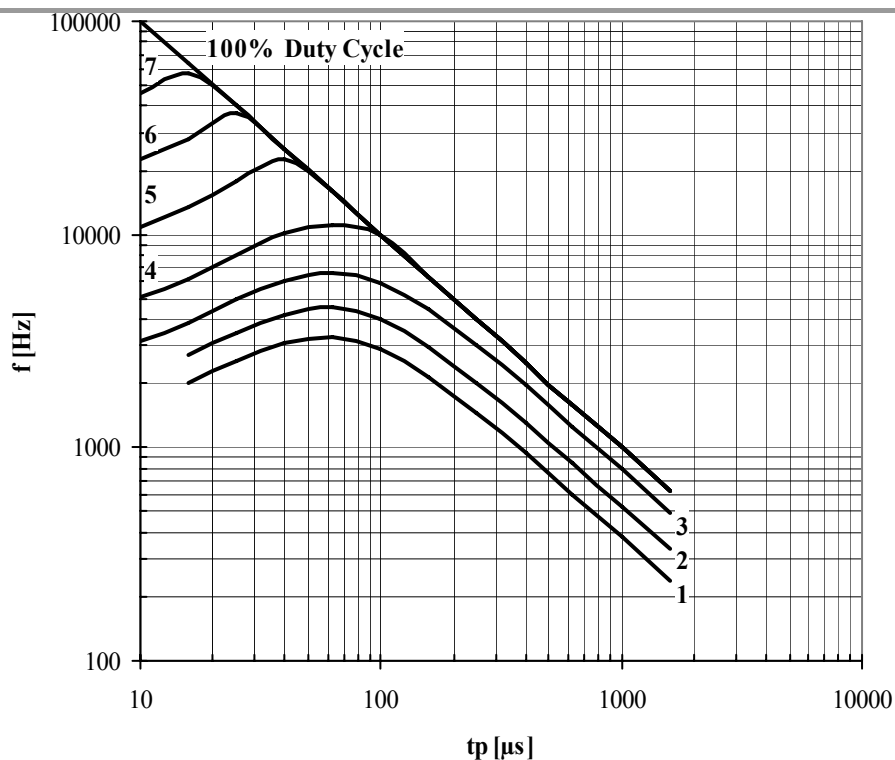


Fig. 12 Sine wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $T_C = 55$ °C

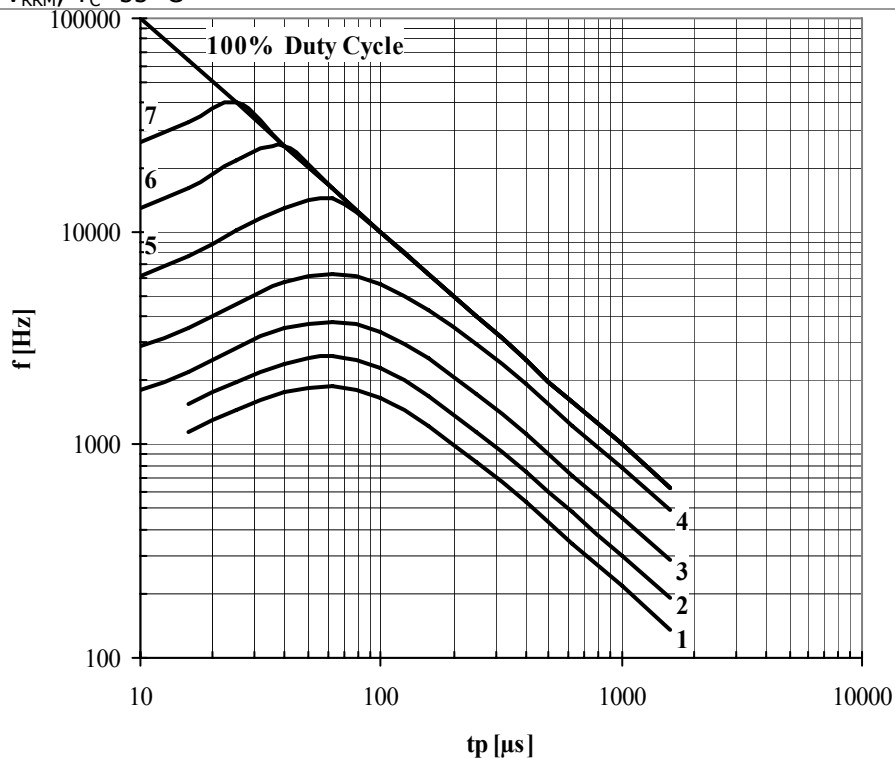


Fig. 13 Sine wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R=0.67 \cdot V_{RRM}$; $T_C=78\text{ }^\circ\text{C}$

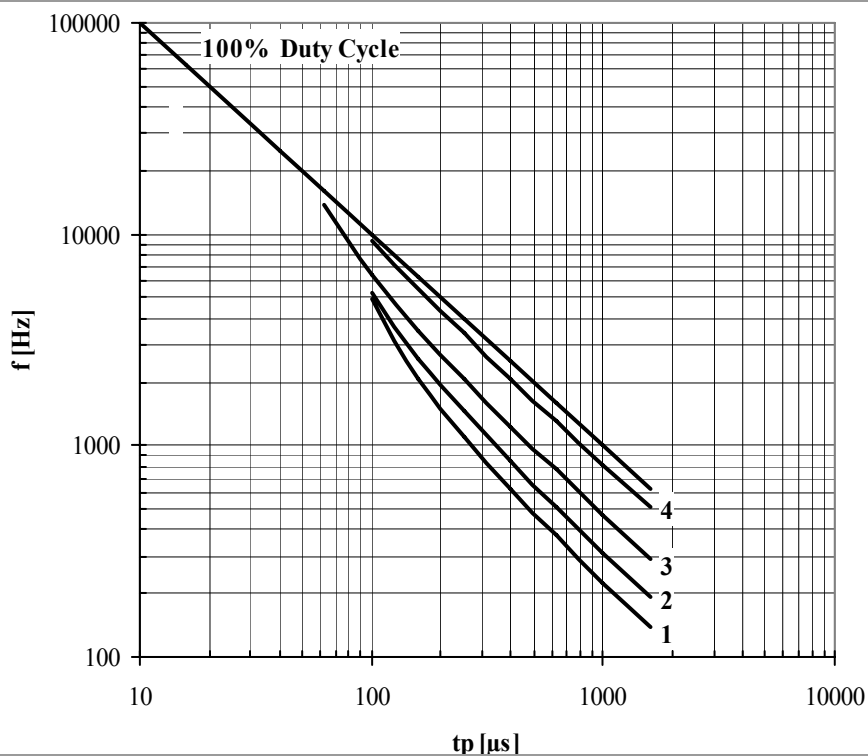


Fig. 14 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000\text{ A}$
- 2 - $I_{TM} = 4000\text{ A}$
- 3 - $I_{TM} = 3000\text{ A}$
- 4 - $I_{TM} = 2000\text{ A}$

Conditions: $V_R \leq 3\text{ V}$; $T_C=55\text{ }^\circ\text{C}$; $di_F/dt=di_R/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$

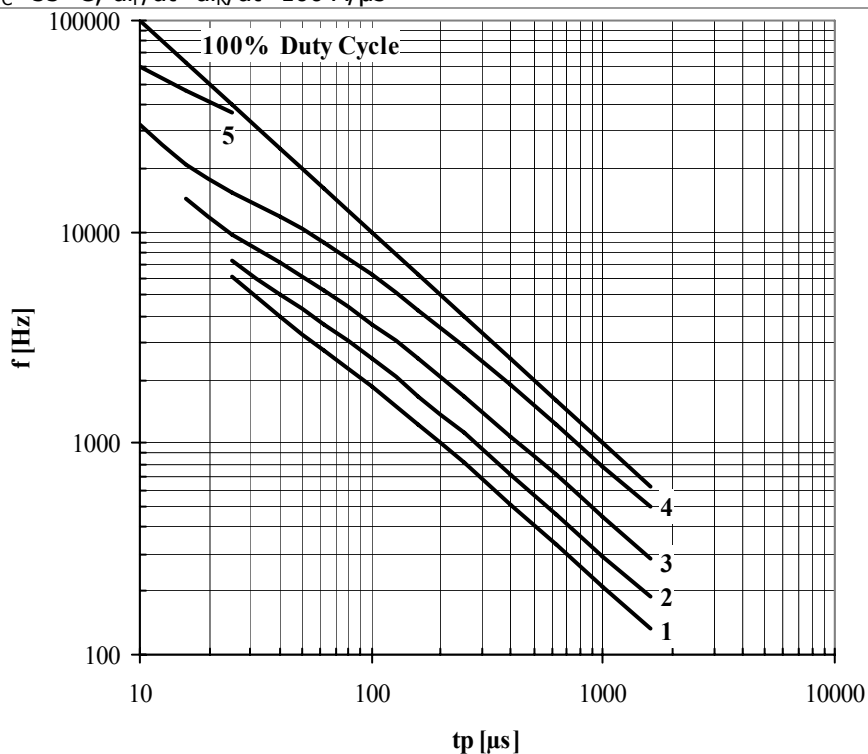


Fig. 15 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000\text{ A}$
- 2 - $I_{TM} = 4000\text{ A}$
- 3 - $I_{TM} = 3000\text{ A}$
- 4 - $I_{TM} = 2000\text{ A}$
- 5 - $I_{TM} = 1000\text{ A}$

Conditions: $V_R \leq 3\text{ V}$; $T_C=55\text{ }^\circ\text{C}$; $di_F/dt=di_R/dt=500\text{ A}/\mu\text{s}$

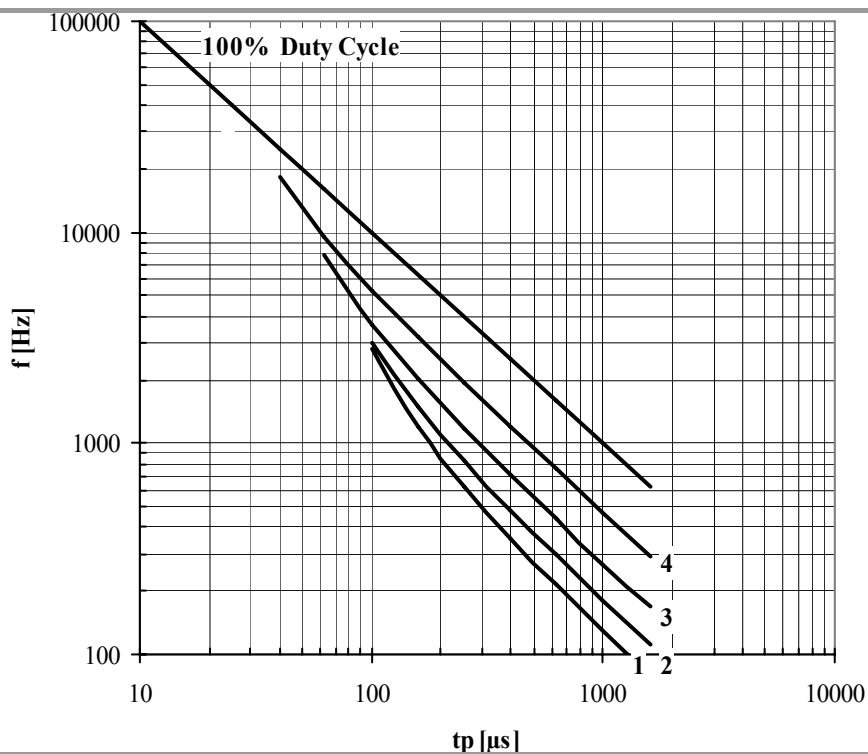


Fig. 16 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V; $T_C = 78$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/μs

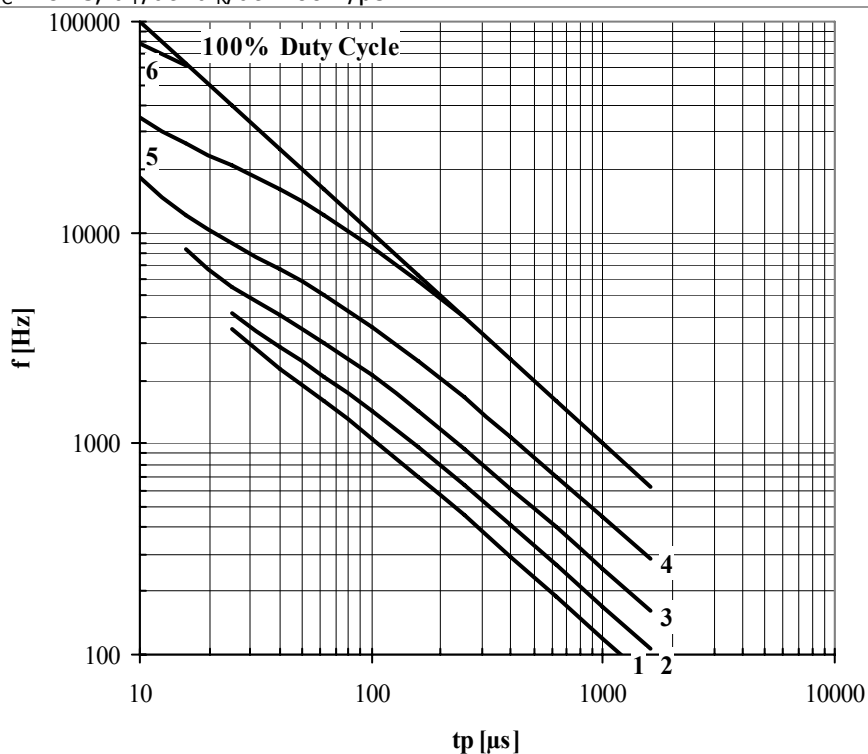


Fig. 17 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V; $T_C = 78$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/μs

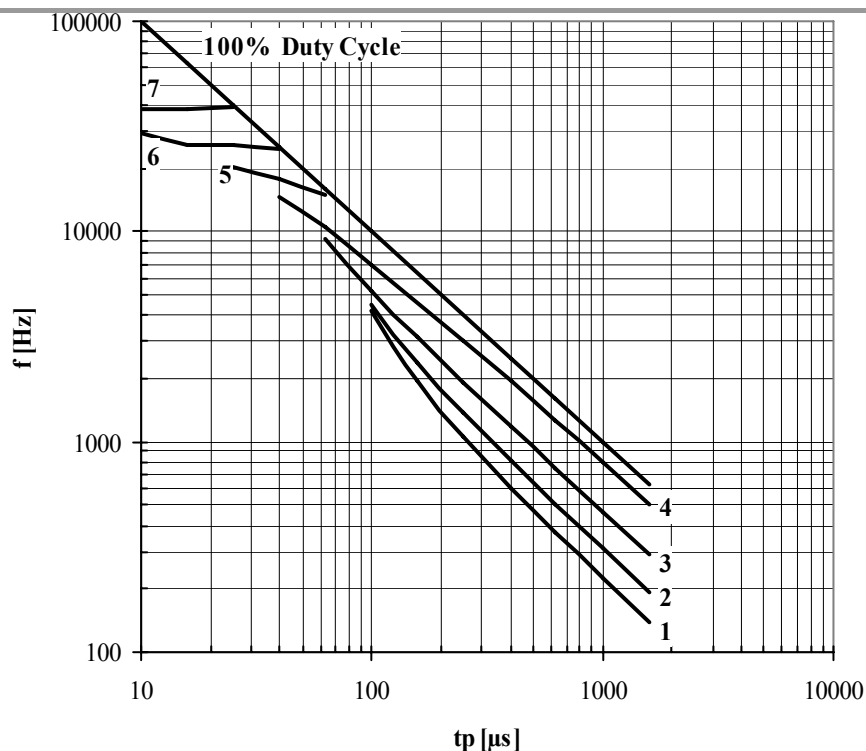


Fig. 18 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $T_C = 55$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/ μ s

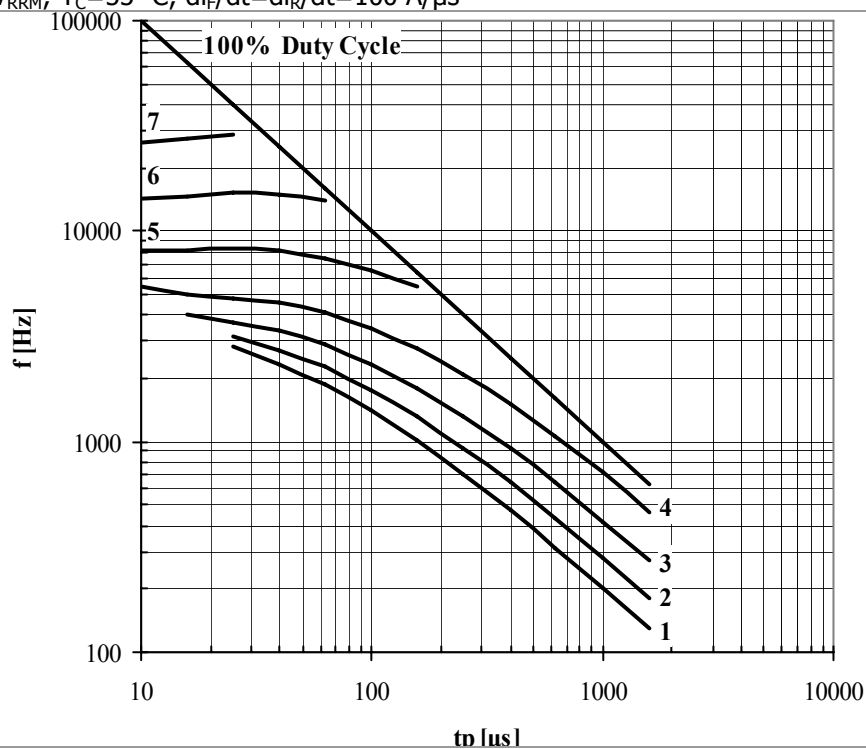


Fig. 19 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $T_C = 55$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/ μ s

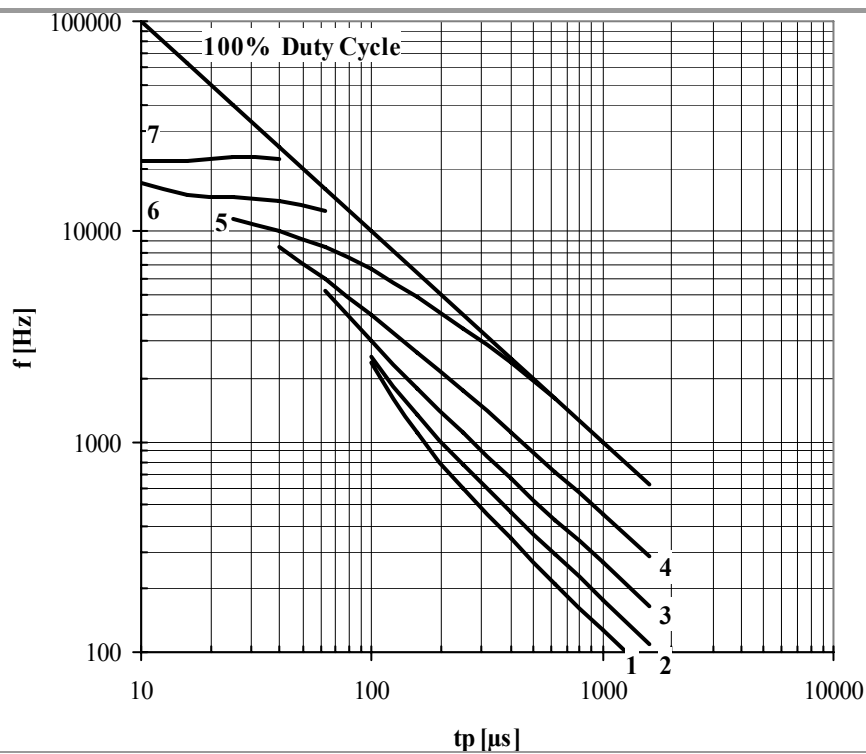


Fig. 20 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $T_C = 78$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/μs

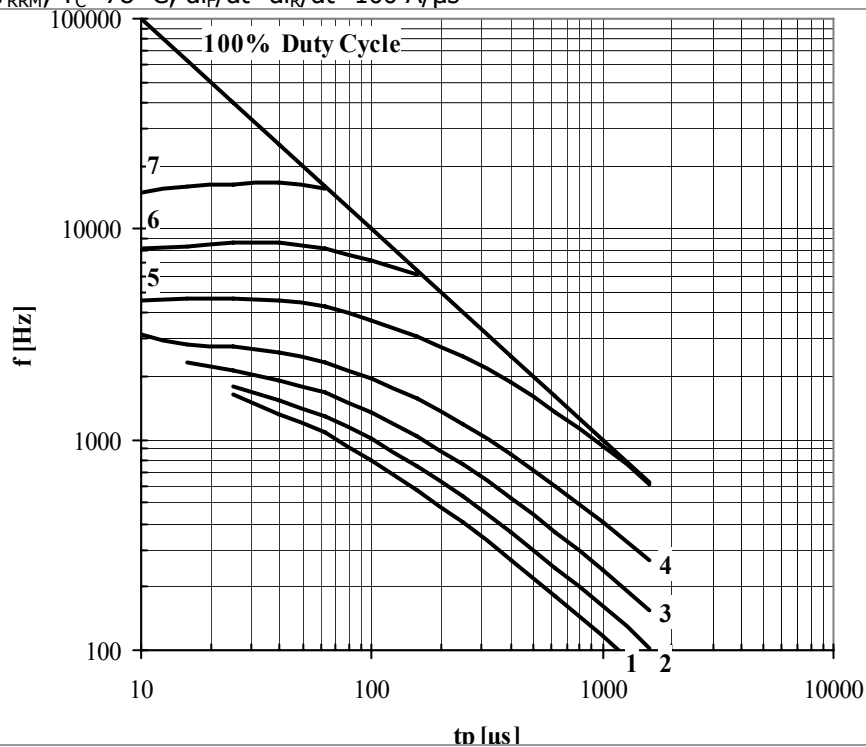


Fig. 21 Square wave frequency ratings

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $T_C = 78$ °C; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/μs

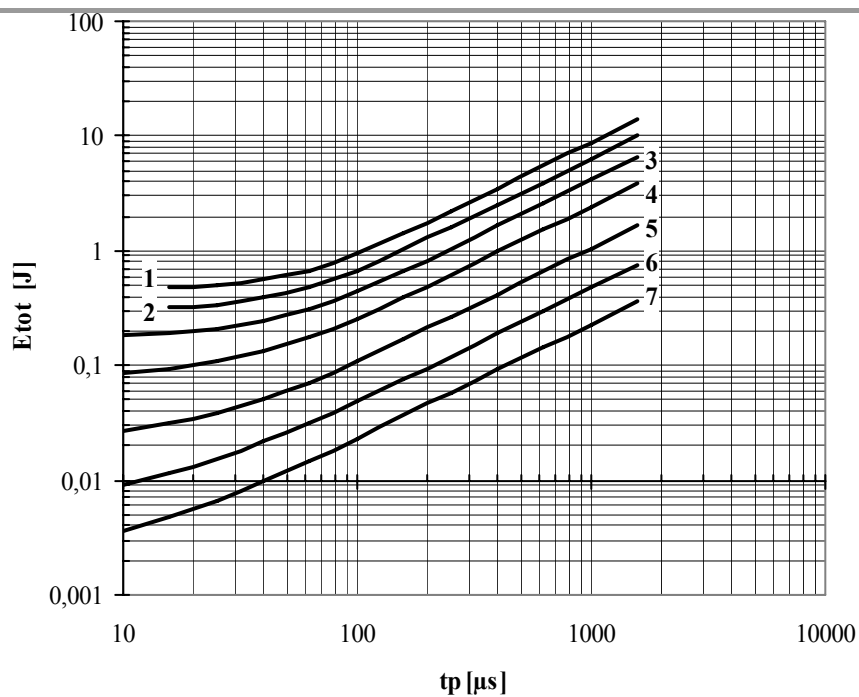


Fig. 22 Sine wave loss energy per pulse

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V

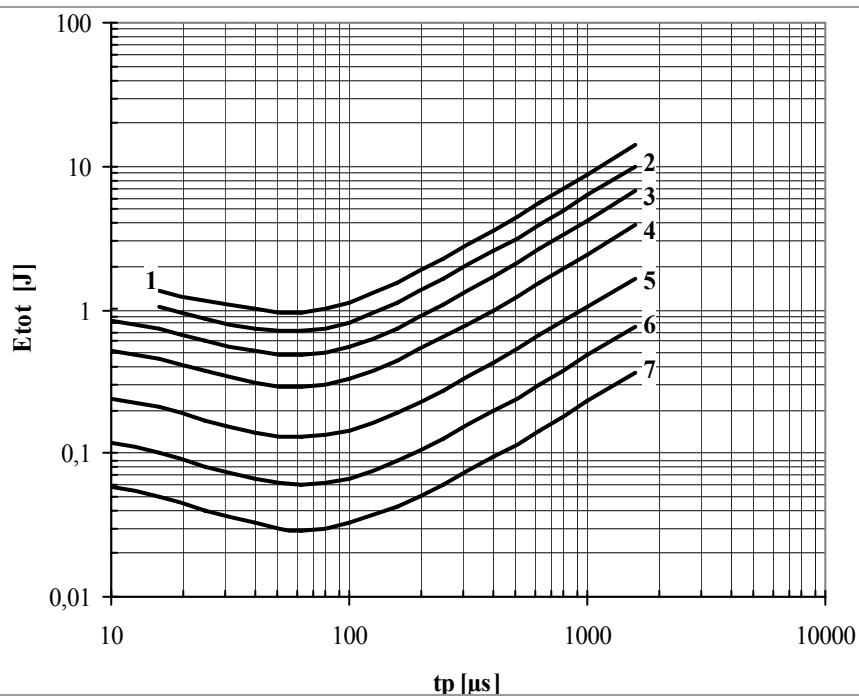


Fig. 23 Sine wave loss energy per pulse

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 V_{RRM}$

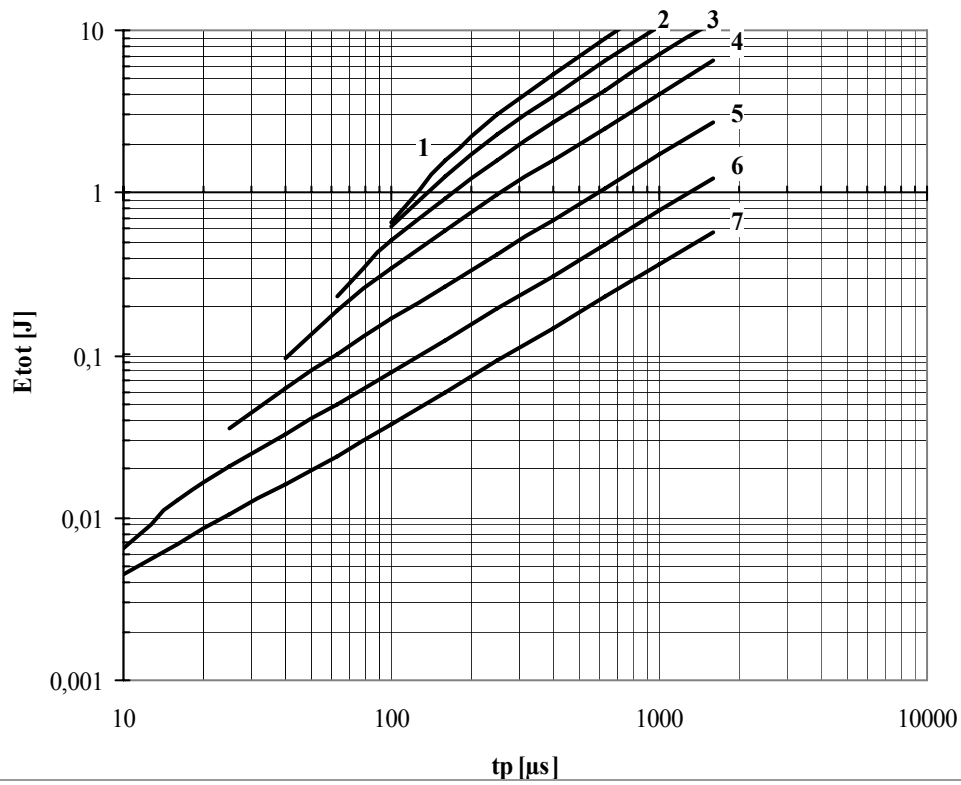


Fig. 24 Square wave loss energy per pulse

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/ μ s

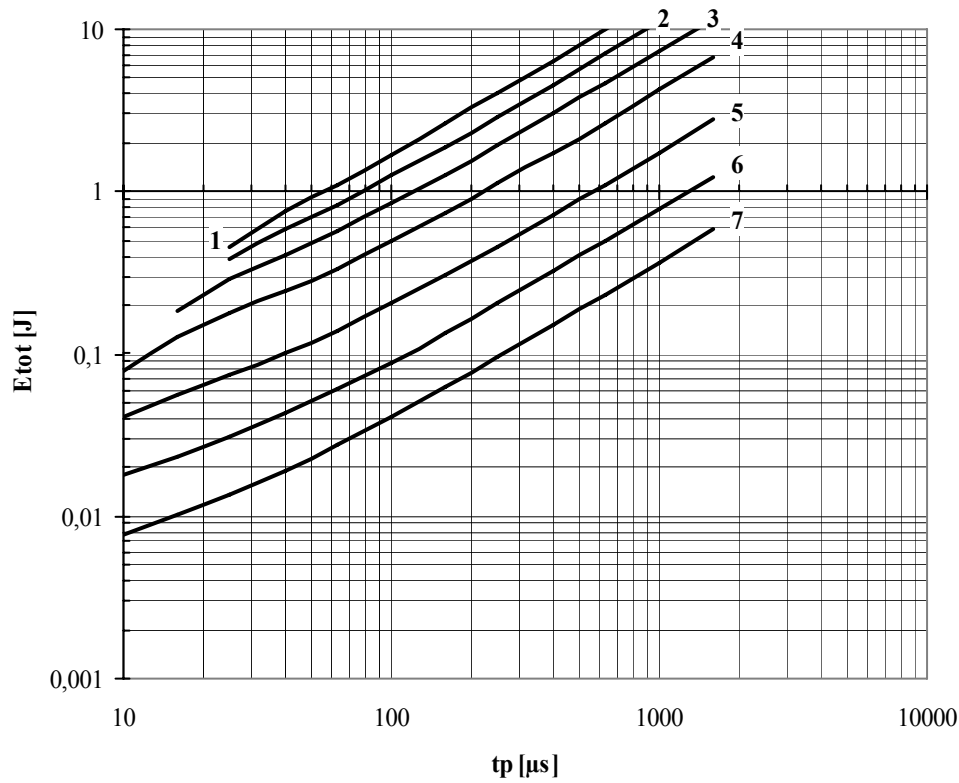


Fig. 25 Square wave loss energy per pulse

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R \leq 3$ V; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/ μs

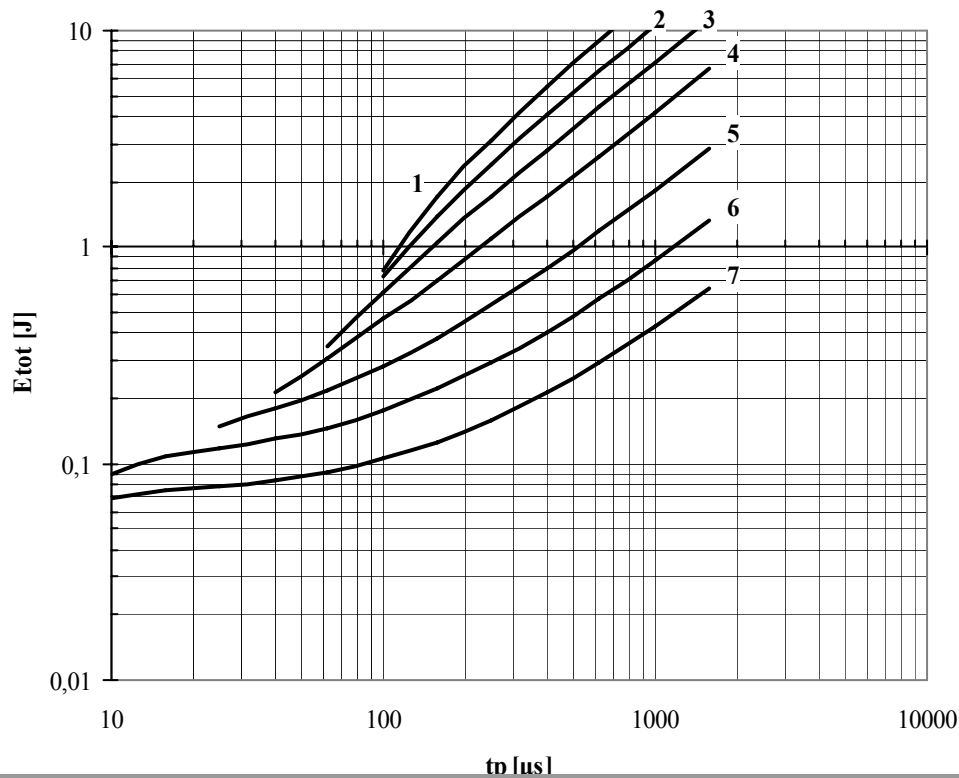


Fig. 26 Square wave loss energy per pulse

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/ μ s

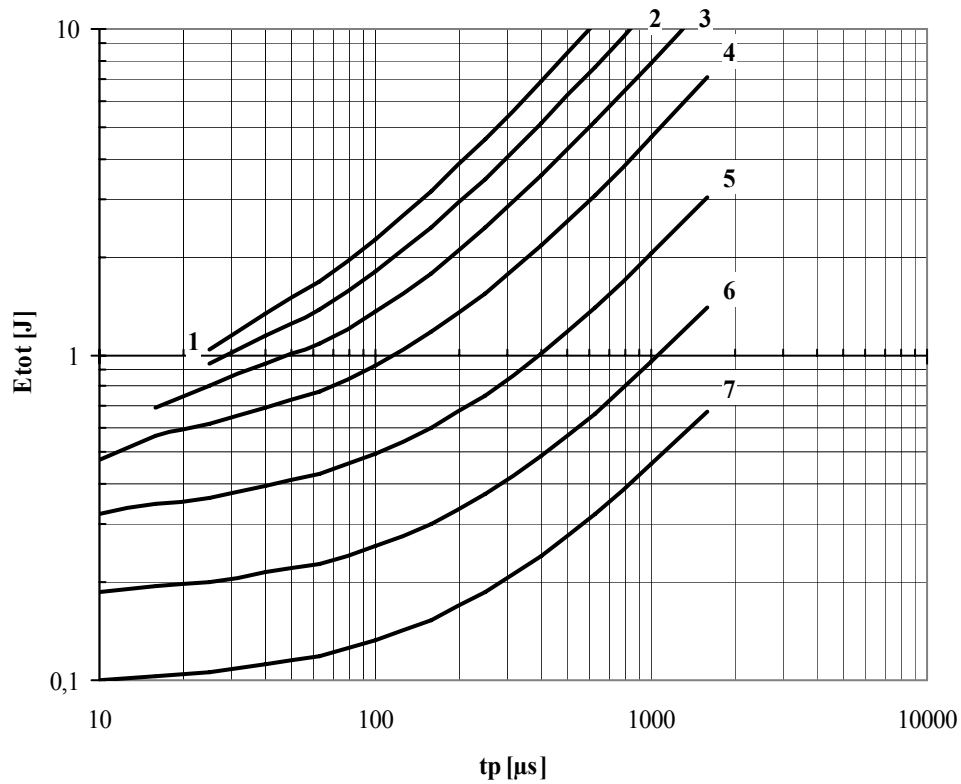


Fig. 27 Square wave loss energy per pulse

- 1 - $I_{TM} = 5000$ A
- 2 - $I_{TM} = 4000$ A
- 3 - $I_{TM} = 3000$ A
- 4 - $I_{TM} = 2000$ A
- 5 - $I_{TM} = 1000$ A
- 6 - $I_{TM} = 500$ A
- 7 - $I_{TM} = 250$ A

Conditions: $V_R = 0.67 \cdot V_{RRM}$; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/ μ s

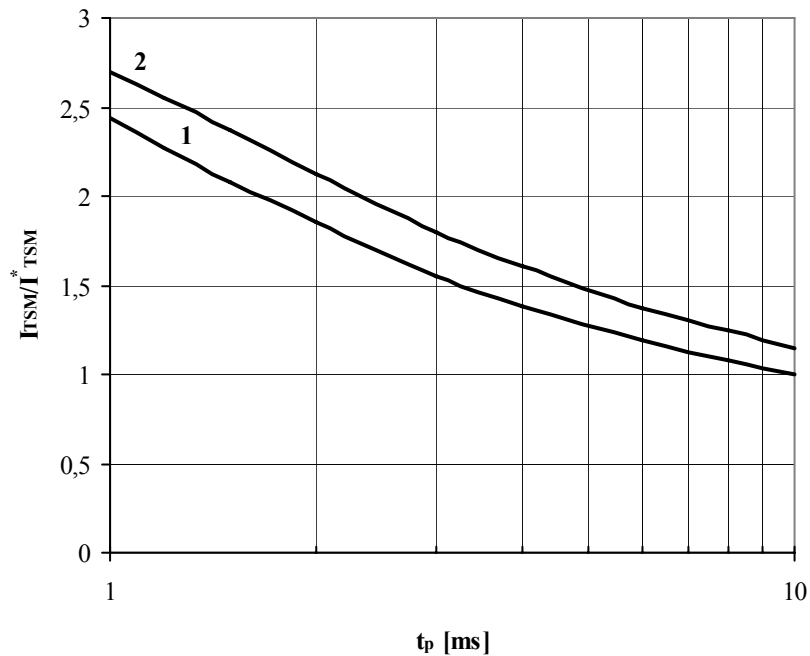


Fig. 28 The surge current I_{TSM} vs. Duration of surge t_p for a half-sine wave
 1 – $T_j=125\text{ °C}$
 2 – $T_j=25\text{ °C}$

Conditions: $V_R=0\text{ V}$ – the peak value of reverse voltage which is applied immediately after the surge current
 Typical changes of I_{TSM} are normalized to the I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – see data sheet, $T_j=T_{j\text{ max}}$)

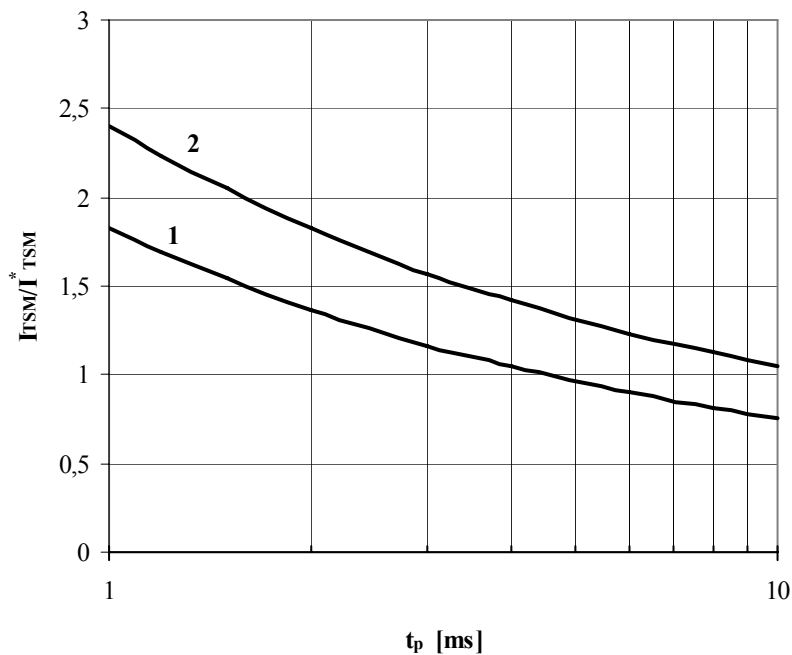


Fig. 29 The surge current I_{TSM} vs. Duration of surge t_p for a half-sine wave
 1 – $T_j=125\text{ °C}$
 2 – $T_j=25\text{ °C}$

Conditions: $V_R=0.8V_{RRM}$ – the peak value of reverse voltage which is applied immediately after the surge current
 Typical changes of I_{TSM} are normalized to the I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – see data sheet, $T_j=T_{j\text{ max}}$)

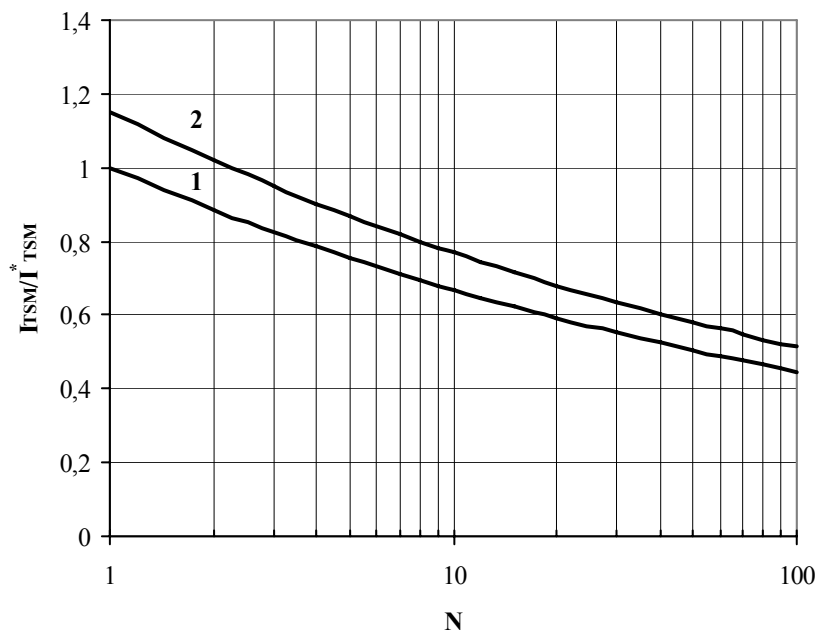


Fig. 30 The surge current I_{TSM} vs. Number of half-sine waves at 50 Hz

1 – $T_j = 125^\circ\text{C}$

2 – $T_j = 25^\circ\text{C}$

Conditions: $V_R = 0\text{ V}$ – the peak value of reverse voltage which is applied immediately after the surge current
 Typical changes of I_{TSM} are normalized to the I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – see data sheet, $T_j = T_{j\text{max}}$)

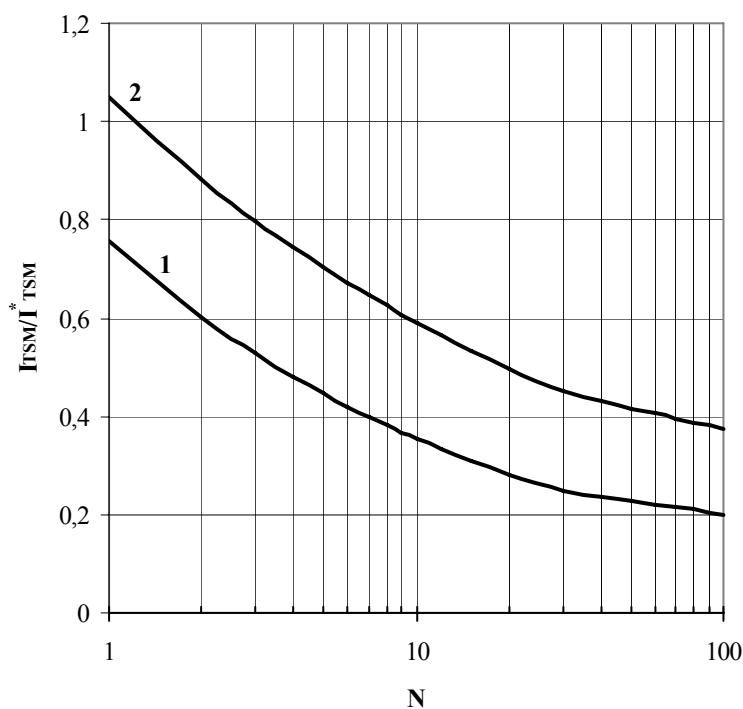


Fig. 31 The surge current I_{TSM} vs. Number of half-sine waves at 50 Hz

1 – $T_j = 125^\circ\text{C}$

2 – $T_j = 25^\circ\text{C}$

Conditions: $V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$ – the peak value of reverse voltage which is applied immediately after the surge current
 Typical changes of I_{TSM} are normalized to the I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – see data sheet, $T_j = T_{j\text{max}}$)